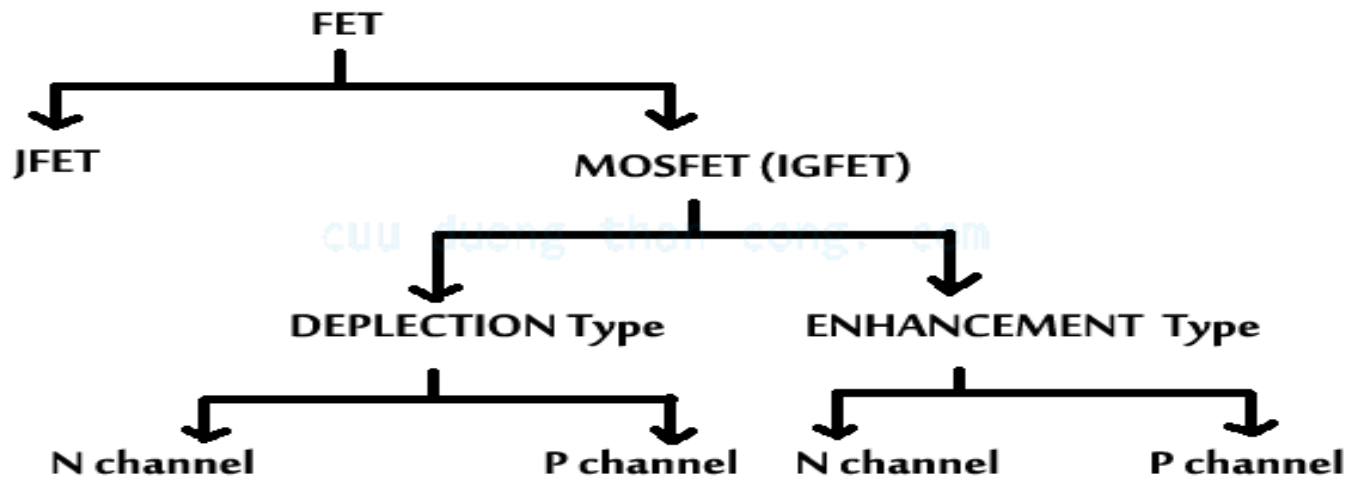


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

I. PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO



FET: Field Effect Transistor

JFET: Junction FET

MOSFET: Metal Oxide Semiconductor FET

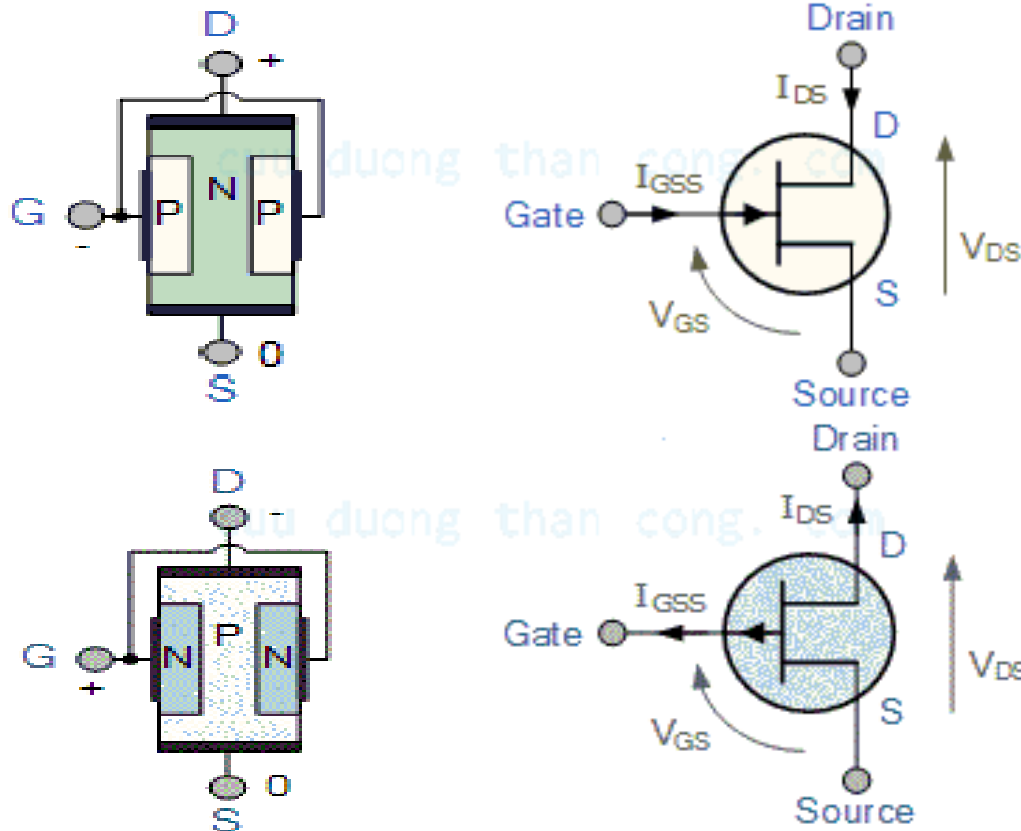
IGFET: Insulated-Gate FET

Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

I. PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO

a. JFET:

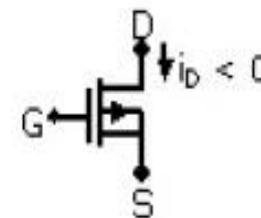
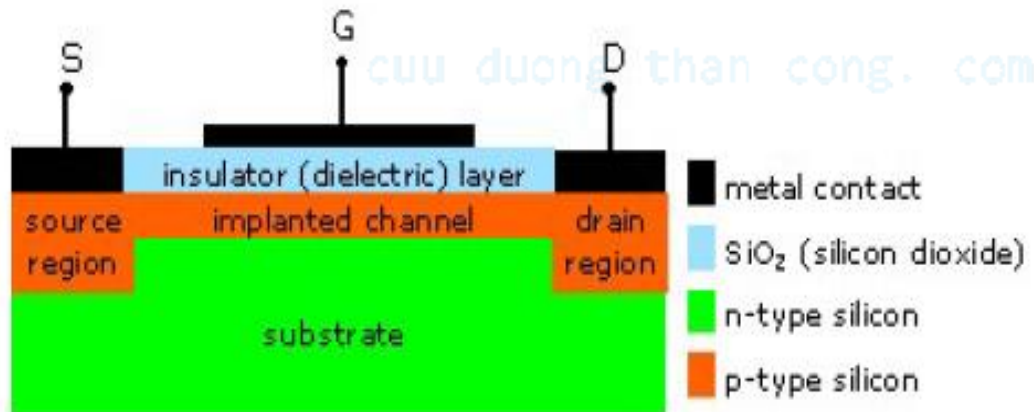
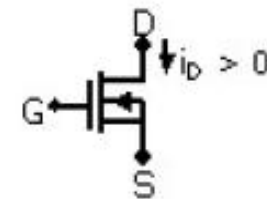
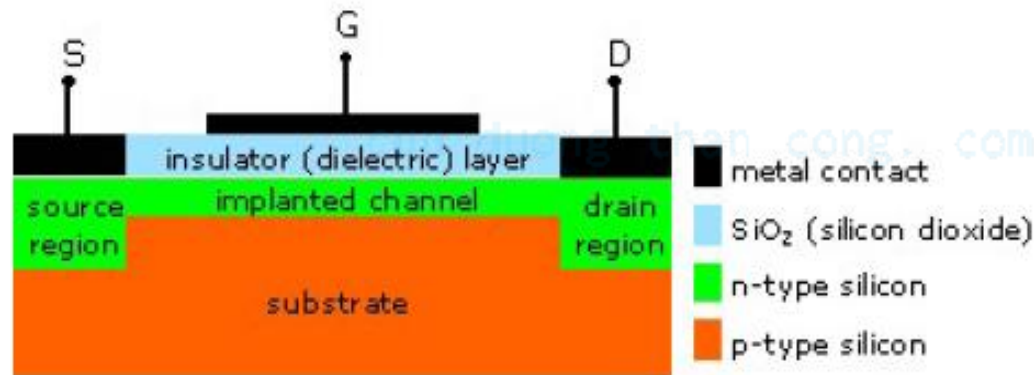


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

I. PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO

b. DEPLETION:

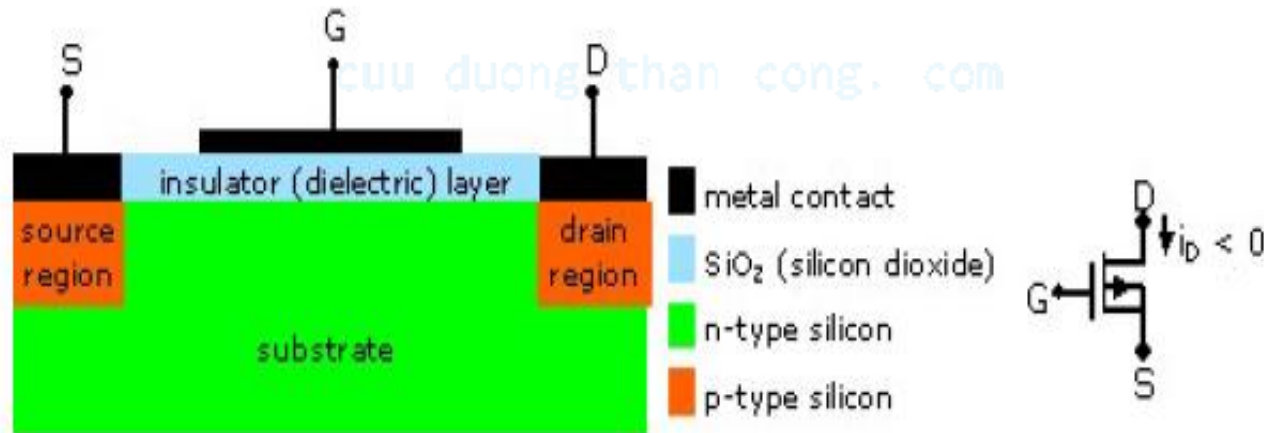
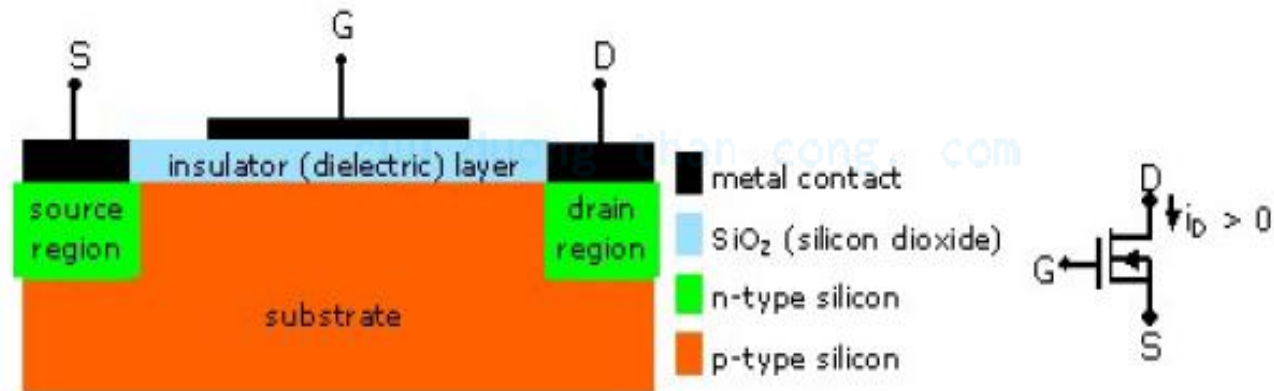


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

I. PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO

C. ENHANCEMENT

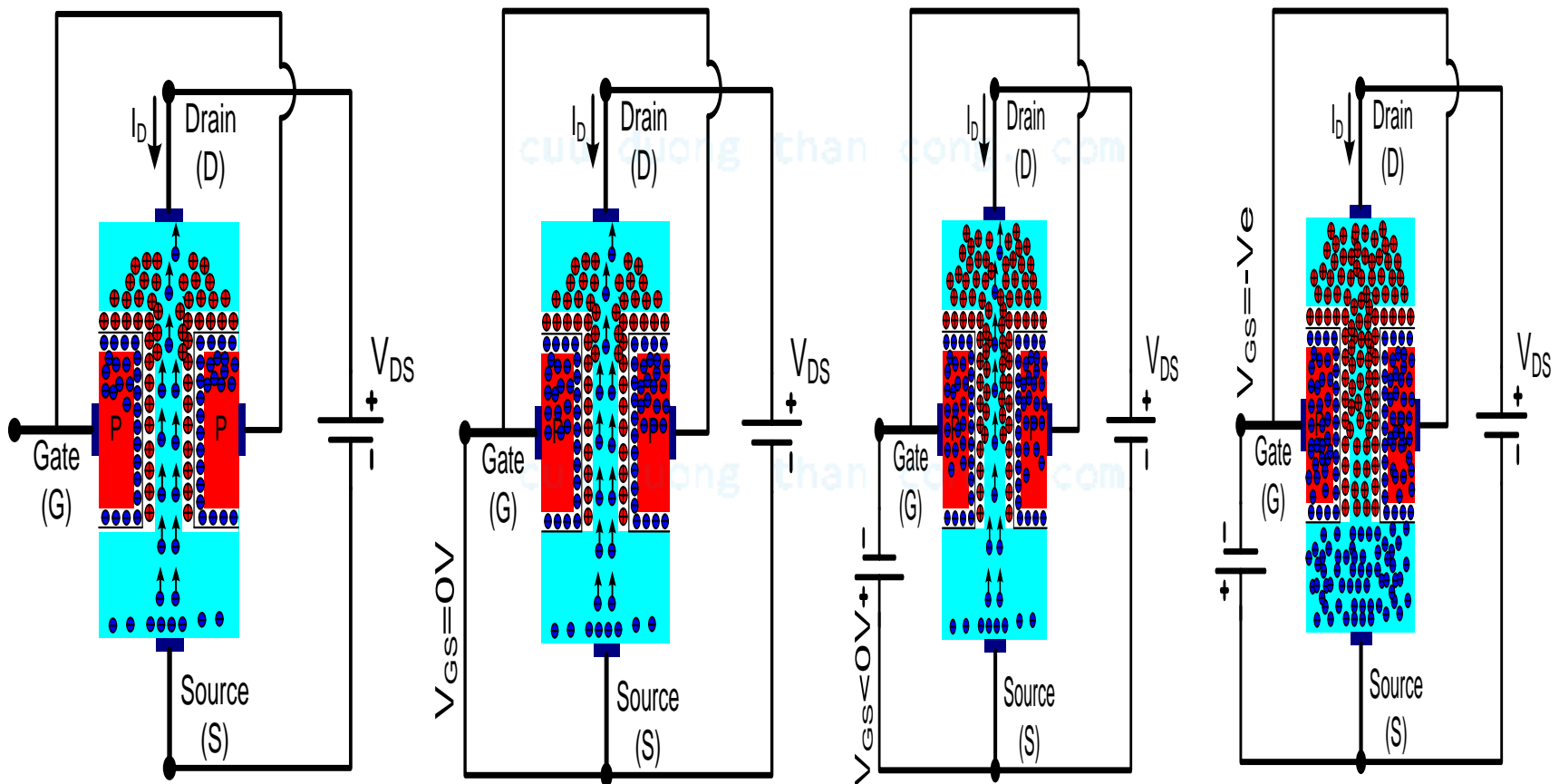


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

II. HOẠT ĐỘNG

a. JFET:

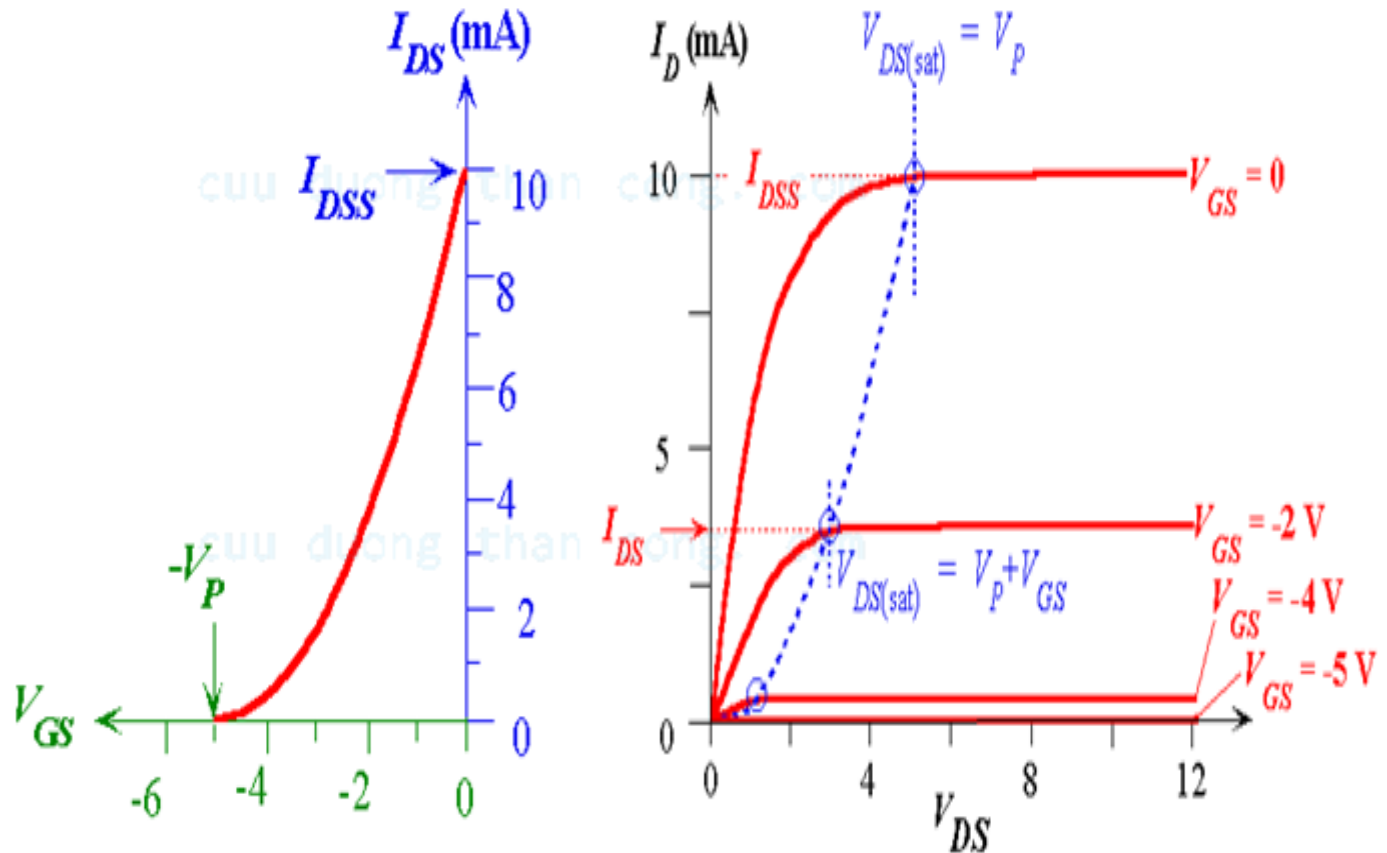


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

II. HOẠT ĐỘNG

a. JFET:

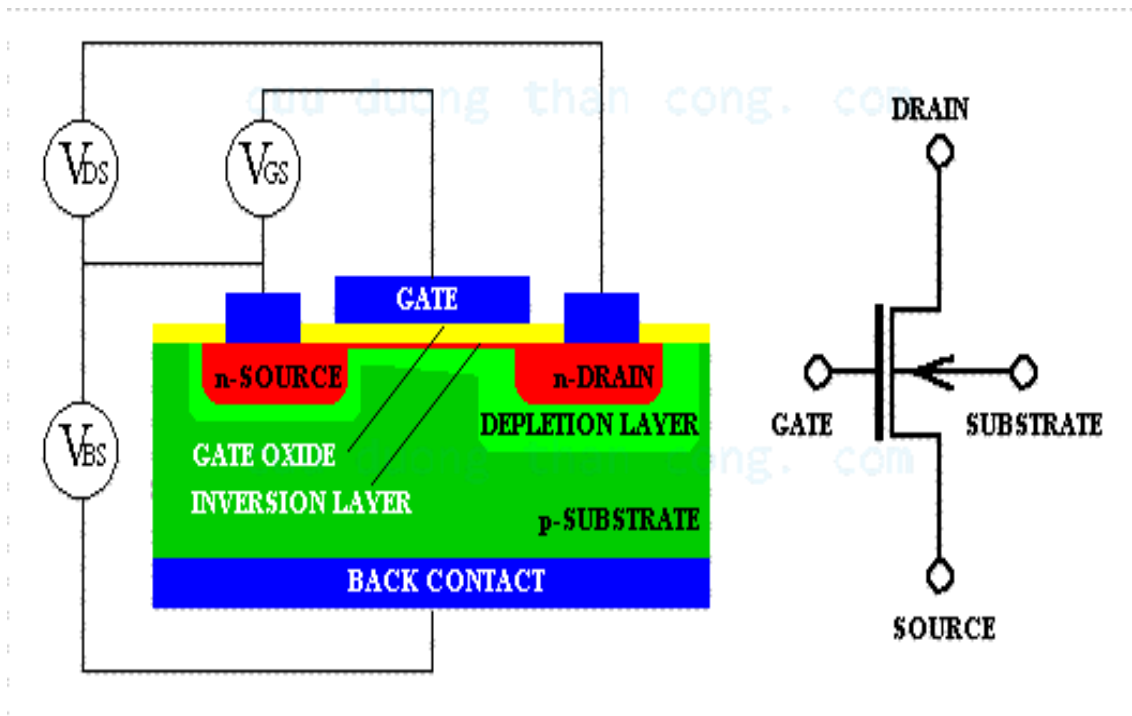


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

II. HOẠT ĐỘNG

b. DEPLETION :

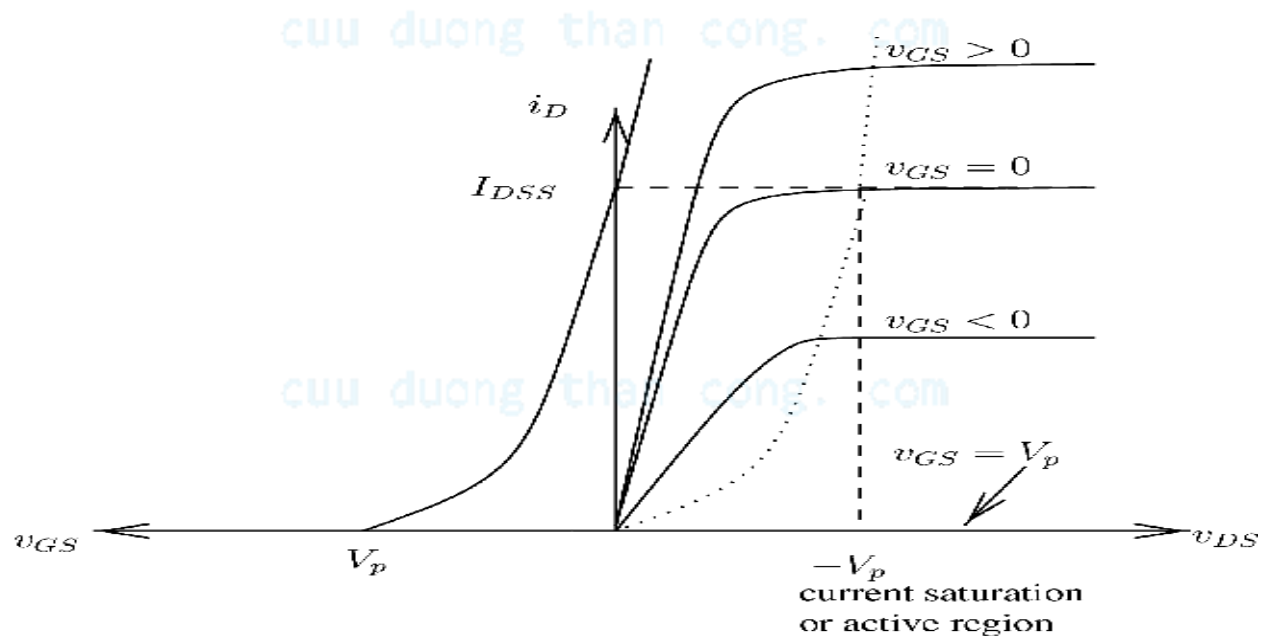


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

II. HOẠT ĐỘNG

b. DEPLETION :

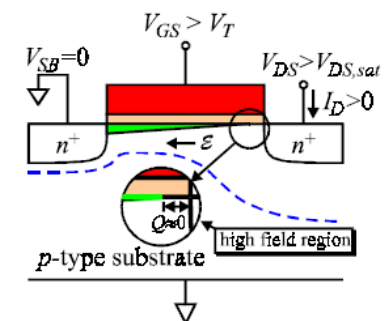
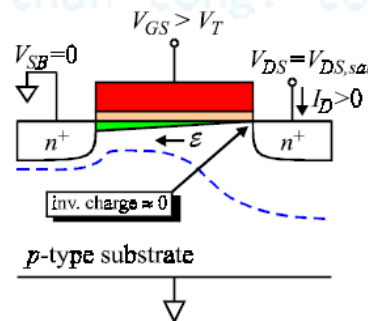
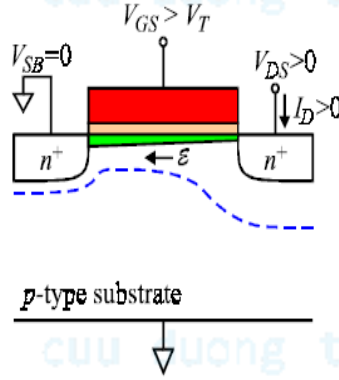
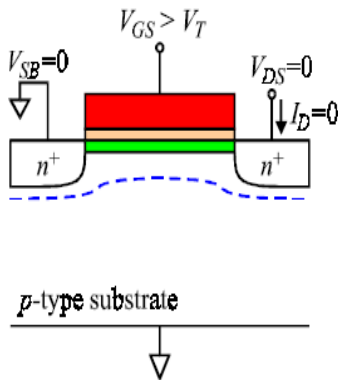
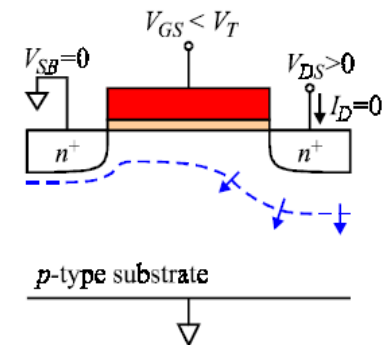
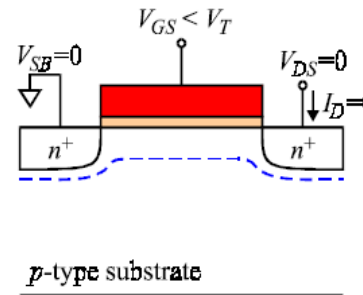


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

II. HOẠT ĐỘNG

C. ENHANCEMENT :

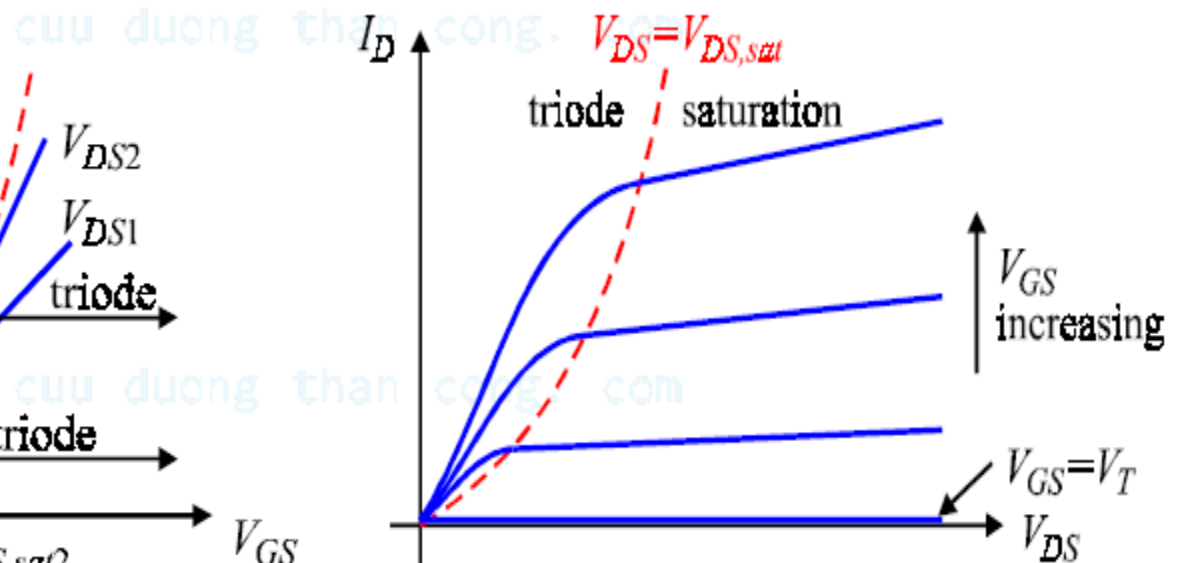
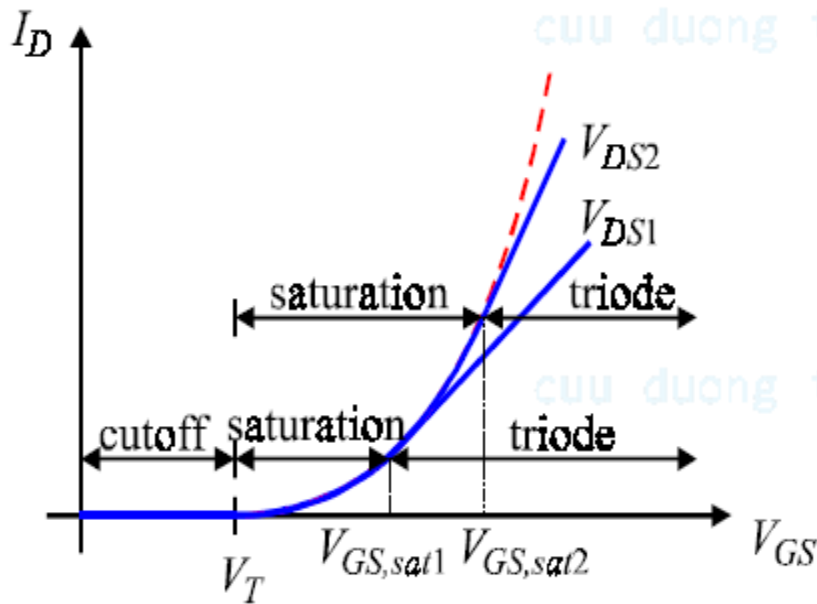


Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

II. HOẠT ĐỘNG

c. ENHANCEMENT :



Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

II. HOẠT ĐỘNG

d. Biểu thức liên hệ:

- JFET và D-MOSFET (Depletion)

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

- E-MOSFET (Enhancement)

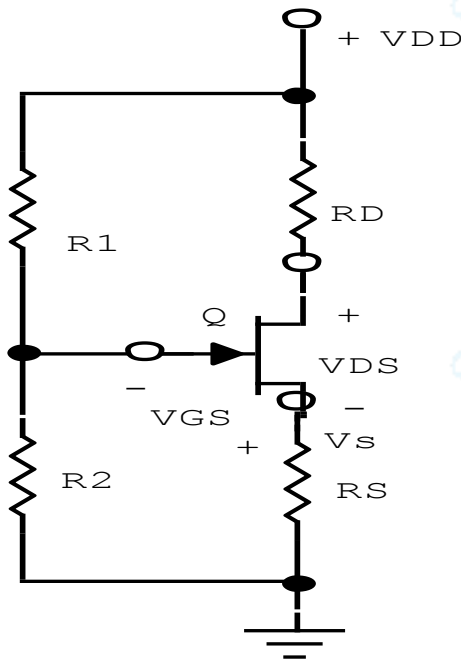
$$I_D = k (V_{GS} - V_T)^2 \quad k = \left(\frac{I_{D(n)}}{V_{GS(n)} - V_T} \right)^2$$

Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

III. PHÂN CỰC

a. Phân cực DC: Mạch phân cực bằng cầu phân thể (ví dụ dùng JFET)



$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$V_S = I_D R_S$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D - I_D R_S$$

Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

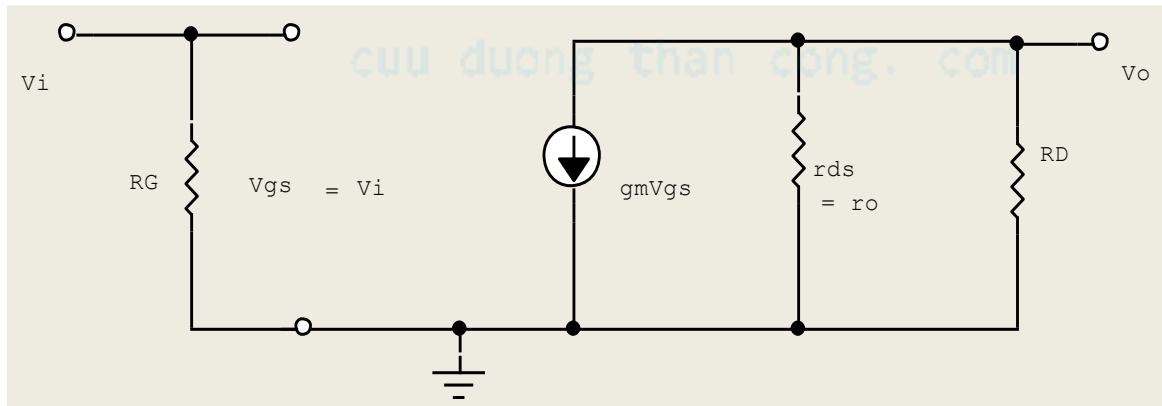
III. PHÂN CỰC

b. Phân cực AC:

- Do I_D là hàm theo V_{GS} , nên ta có hệ số truyền dẫn:

$$g_m = \frac{dI_D}{dV_{GS}}$$

- Mô hình tương đương



Điện tử căn bản

Bài: Transistor hiệu ứng trường(FET)

IV. MỘT SỐ ỨNG DỤNG

- a. Ký hiệu, mô hình MOSFET dạng tăng cường
- b. Các kiểu tác động, kích thích
- c. Mức logic theo TTL, CMOS
- d. Hệ thống số
- e. Đại số BOOLE
- f. ROM, RAM
- g. Các cổng logic